

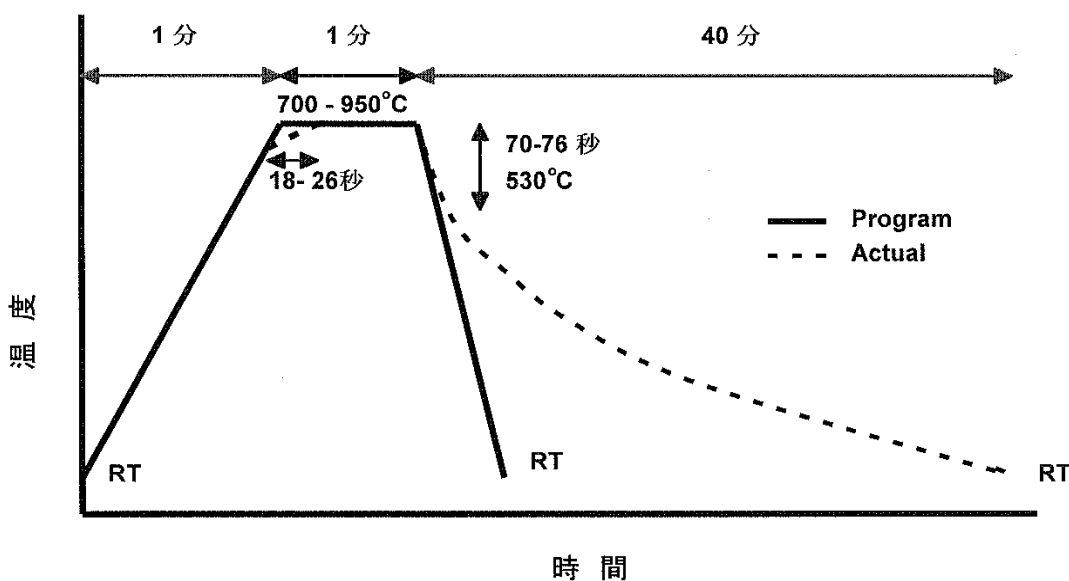
技術の名称

半導体発光素子の製造方法

適用分野

量子ドットレーザ

- 目的 均一なサイズを有する量子ドットを含む半導体発光素子の製造方法を提供する。
- 効果 本発明方法によれば、量子ドットの存在を確保したまま量子ドットとキャップ層との間で原子の拡散が生じて量子ドットが再構成されるので、均一なサイズを有する量子ドットを含む半導体発光素子を製造することができる。
- 技術概要 本発明方法は、基板の上にバッファ層、クラッド層、バリア層、活性層、バリア層、クラッド層、コンタクト層を順次積層した半導体基板を、量子ドットの存在を確保できる基準昇温速度以上の速度で急温して熱処理を行い、その後、室温まで急冷する。

■ 特記事項、
図など

- 主たる提供特許 特許等の名称 : 半導体光素子の製造方法
登録番号 :
出願番号 : 特願2007-320621 出願日 : 平成19年12月12日
公開番号 :
- 実施実績 有、 ○無 ■ 提供形態 ○実施許諾、 ×権利譲渡

お問合せ先 株式会社 国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 経営統括部 知的財産チーム
〒619-0288 京都「けいはんな学研都市」光台二丁目2番地2
Tel 0774-95-2521 E-mail ; patent@atr.jp